

日程表 (会場別) I

武蔵工業大学

会場名	収容人数	3月22日(水)		3月23日(木)		3月24日(金)		3月25日(土)		3月26日(日)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
8号館	A 1F-814	108	15.4 トライボロジー 15.1 応用物理一般	15.1 応用物理一般		「諸外国の物理教育の現状と動向」国際会議の役割は?」		「衝撃現象と極限環境プロセス」			15.7 磁場応用	15.7 磁場応用
	B 1F-815	108	12.3 プロセス技術・界面制御	12.3 プロセス技術・界面制御	3.9 光学新領域	「広島・長崎原爆放射線量新評価システム DS02と環境放射線計測技術」	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造		
	C 2F-820	171	3.8 近接場光学	3.8 近接場光学	半導体 A (シリコン) 分科内総合講演「Cu/ Low-k 多層配線技術の現状と今後の課題」		15.5 エネルギー変換・貯蔵 15.6 資源・環境	「エネルギーデバイスの革新が抱く持続可能社会実現への道」応用物理学会の新な挑戦に向けたビジョン・宣言」	13.4 III-V 窒化物結晶	「励起ナノプロセス」の展望	12.1 探索的材料物性	12.1 探索的材料物性
	D 2F-821	106	3.3 機器・デバイス光学	3.3 機器・デバイス光学	3.8 近接場光学	3.8 近接場光学	10.6 高分子・ソフトマテリアル	「シリコン光エミッタ」	12.1 探索的材料物性	12.1 探索的材料物性	5.2 光検出	
	E 2F-822	106	3.1 物理光学・光学基礎	3.2 材料光学	3.5 情報光学	3.5 情報光学	7.1 X線技術	7.1 X線技術	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー
	F 2F-823	106	7.5 ビーム・光励起表面反応	7.5 ビーム・光励起表面反応	7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般	7.4 ナノインプリント	7.7 微小電子源	7.7 微小電子源	7.8 ビーム応用一般・新技術	7.8 ビーム応用一般・新技術
	G 3F-831	106	8.1 磁性材料・磁気デバイス	8.1 磁性材料・磁気デバイス	8.3 微粒子・粉体	8.3 微粒子・粉体	8.4 ナノエレクトロニクス	8.4 ナノエレクトロニクス	8.5 熱電変換	8.5 熱電変換	8.5 熱電変換	
	H 3F-832	106	9.2 新材料、新薄膜、新低温動作デバイス 9.6 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	9.6 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	9.5 アナログ応用および関連技術		9.1 基礎物性	9.1 基礎物性	8.6 新機能材料・新物性			
	I 3F-833	106	10.10 特定テーマ B: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー	10.10 特定テーマ B: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー	10.10 特定テーマ B: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー		10.10 特定テーマ B: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	
	J 3F-834	106					11.4 配線技術	11.4 配線技術	11.4 配線技術			
	7号館	K 3F-835	108	2.1 計測・制御技術	2.1 計測・制御技術	2.2 精密計測・ナノ計測 2.3 計測標準	2.3 計測標準	9.4 臨界電流、超伝導パワー応用	9.4 臨界電流、超伝導パワー応用	9.3 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長	9.3 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長	
L 1F-711		130	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	光・量子エレクトロニクス業績賞記念講演 4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス	4.7 レーザー・プロセス
M 1F-712		129	1.4 プラズマ応用プロセス	9.5 アナログ応用および関連技術	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	1.1 放射線・加速器・原子炉	1.1 放射線・加速器・原子炉	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学
N 1F-713		129	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性
P 1F-714		129	合同セッション D「プラズマ CVD の基礎と応用」	10.5 液晶	10.5 液晶		13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料
Q 2F-721		130	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶 13.7 エピタキシャルの基礎	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	10.4 光機能材料・デバイス	10.4 光機能材料・デバイス	10.4 光機能材料・デバイス	10.4 光機能材料・デバイス
R 2F-722		130	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡
S 2F-723		130	10.3 電子機能材料・デバイス	10.3 電子機能材料・デバイス	10.3 電子機能材料・デバイス	10.3 電子機能材料・デバイス	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜
T 2F-724		130	6.5 表面物理・真空	「真空を利用した分析機器—質量分析計」	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	合同セッション G「量子情報の基礎と応用」	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶	13.3 III-V 族エピタキシャル結晶		
V 3F-731		130	11.1 基礎物性・評価	11.1 基礎物性・評価	11.1 基礎物性・評価	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術	11.3 絶縁膜技術
W 3F-732		130	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	1.3 反応性プラズマの診断と計測	5.4 光制御		
X 3F-733	130	3.6 視覚・色彩 3.7 生体・医用光学	15.3 新技術	11.6 Si デバイス/集積化技術	11.7 シミュレーション	11.6 Si デバイス/集積化技術	11.6 Si デバイス/集積化技術	11.6 Si デバイス/集積化技術	11.6 Si デバイス/集積化技術	11.6 Si デバイス/集積化技術	11.6 Si デバイス/集積化技術	
Y 3F-734	130	5.4 光制御	光・電子集積技術業績賞記念講演 5.4 光制御	14.2 プロセス技術	14 非晶質・微結晶分科内招待講演 14.2 プロセス技術	5.4 光制御	5.5 光ファイバー	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御		
ZA 4F-741	109	「半導体のプロセス・デバイス・回路のモデリングとシミュレーション」		1.7 プラズマエッチング	1.7 プラズマエッチング	14.1 基礎物性・評価		14.1 基礎物性・評価	14.1 基礎物性・評価			

日程表 (会場別) 2

武蔵工業大学

会場名	収容人数	3月22日(水)		3月23日(木)		3月24日(金)		3月25日(土)		3月26日(日)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
7号館	ZB 4F-742	130	13.8 結晶評価、 ナノ不純物・結 晶欠陥	13.8 結晶評価、 ナノ不純物・結 晶欠陥	スクールA 「応用物理が活躍する環境テクノロ ジーの現状と将来」		スクールB 「科学技術の基盤としての標準・基 礎定数の研究と教育への導入」		7.3 リソグラ フィ	7.3 リソグラ フィ	7.3 リソグラ フィ	
	ZC 4F-743	109	1.2 プラズマ生 成技術およびプ ラズマ源	1.2 プラズマ生 成技術およびプ ラズマ源	1.2 プラズマ生 成技術およびプ ラズマ源	1.2 プラズマ生 成技術およびプ ラズマ源	1.3 反応性プ ラズマの診断と計 測		1.6 プラズマ現 象一般	1.6 プラズマ現 象一般	1.5 プラズマプ ロセスによるナ ノテクノロジー	1.5 プラズマプ ロセスによるナ ノテクノロジー
	ZD 4F-744	130		合同G分科内総 合講演「光子数 識別技術の現状 と将来展望」	13.5 IV族結晶、 IV-IV族混晶	13.1 ハルク結 晶成長	3.4 計測光学	「光のスペクトル に着目した光波 センシング」	3.4 計測光学	3.4 計測光学	3.4 計測光学	
6号館	ZE B1F-6B1	193	13.5 IV族結晶、 IV-IV族混晶	13.5 IV族結晶、 IV-IV族混晶	12.4 超高速・機 能デバイス	超伝導分科企 画「発見から20 年、高温超伝導 研究の最前線」	12.4 超高速・機 能デバイス	「メートル級大面 積プラズマプロ セスの現状と展 望」	13.4 III-V 窒 化物結晶	13.4 III-V 窒 化物結晶	13.4 III-V 窒 化物結晶	13.4 III-V 窒 化物結晶
	ZF B1F-6B2	394	13.4 III-V 窒 化物結晶	13.4 III-V 窒 化物結晶	13.4 III-V 窒 化物結晶	「光技術と技術経 営(II)-国際競争 力回復を目指し て」	13.4 III-V 窒 化物結晶	結晶工学分科会、シリコ ンテクノロジー分科会共 同企画「極薄・高導電 電カトンジスタを実現 する結晶材料・プロセ スデバイス技術」	日本学術振興会第161委員会・第 145委員会・第175委員会合同企 画「Siバルク結晶太陽電池の現状 と課題」	13.4 III-V 窒 化物結晶	13.4 III-V 窒 化物結晶	
	ZG 2F-621	310	6.2 カーボン系 薄膜	「応用物理ともの づくり-応用物理 学会と産業界の 層の連携を目指し て」	10.9 特定テ ーマA:有機トラ ンジスター	「電子デバイスを 目指したバイオテ クノロジーとナ ノテクノロジーの融 合」	10.9 特定テ ーマA:有機トラ ンジスター	「酸化亜鉛薄膜に おける次充制御 による物性設計」	10.9 特定テ ーマA:有機トラ ンジスター	10.9 特定テ ーマA:有機トラ ンジスター	10.9 特定テ ーマA:有機トラ ンジスター	10.9 特定テ ーマA:有機トラ ンジスター
	ZH 3F-632	134	13.2 II-VI 族 結晶	13.2 II-VI 族 結晶			13.4 III-V 窒 化物結晶			12.5 半導体光 物性・光デバイ ス		
	ZK 3F-633	218	10.9 特定テ ーマA:有機トラ ンジスター	薄膜・表面物理分 科会企画「ナノ サイエンスとし てのカーボンナ ノチューブ研究」	13.4 III-V 窒 化物結晶	日本学術振興会ナ ノテクノロジー分 科会企画「走査プロ ブ顕微鏡のロード マップ」	10.8 有機EL	「翼を広げる分 極反転光デバイ ス」	10.8 有機EL	「生命の世界・視 えるものと観た いもの」	10.8 有機EL	10.8 有機EL
5号館	ZL B1F- 小講堂	160	1.7 プラズマエ ッチング分科内総 合講演「プラズマ エッチングの限界 と展開」	1.7 プラズマエ ッチング分科内総 合講演「プラズマ エッチングの限界 と展開」	業績賞記念講演/ 志水隆一氏 7.2 電子顕微鏡、 評価、測定、分析	光学論文賞受賞 記念講演	応用物理学会 M&E 日本分光学会テ ラヘルツ分光部会テラヘルツ電磁波技術 研究会合同企画「有機・生体分子の分光 センシングの新潮流:テラヘルツ波と表 面波による分光法」	13.4 III-V 窒 化物結晶		「ナノ光電子機能 を探索する」		
3号館	ZM 1F-311	170	合同セッションE 「スピントロニクス ・ナノマグネ ティクス」	合同セッションE 「スピントロニクス ・ナノマグネ ティクス」	合同セッションE 「スピントロニクス ・ナノマグネ ティクス」	「スピントロニクス デバイスへ向 けての最前線」	合同セッションE 「スピントロニクス ・ナノマグネ ティクス」	「ランダム系フォ トエレクトロニクス の進展」	合同セッションE 「スピントロニクス ・ナノマグネ ティクス」	合同セッションE 「スピントロニクス ・ナノマグネ ティクス」	合同セッションE 「スピントロニクス ・ナノマグネ ティクス」	合同セッションE 「スピントロニクス ・ナノマグネ ティクス」
	ZN 1F-312	170	5.1 半導体レー ザー・発光素子	業績賞記念講演/ 伊賀健一氏 5.1 半導体レー ザー・発光素子	5.1 半導体レー ザー・発光素子	「光インターコネ クション-帯内 光接続から次世代 Super Computer 応用へ向けて」	合同セッションF 「カーボンナノ チューブの基礎 と応用」	合同セッションF 「カーボンナノ チューブの基礎 と応用」	合同セッションF 「カーボンナノ チューブの基礎 と応用」	合同セッションF 「カーボンナノ チューブの基礎 と応用」	12.5 半導体光 物性・光デバイ ス	
	ZP 2F-321	170	合同セッションF 「カーボンナノ チューブの基礎 と応用」	合同セッションD 「プラズマCVD の基礎と応用」	合同セッションF 「カーボンナノ チューブの基礎 と応用」	合同セッションF 「カーボンナノ チューブの基礎 と応用」	13.6 IV 族系化 合物	「有機光・電子機 能媒質の構造化: 光波の多様な制 御を目指して」	合同セッションK 「酸化亜鉛系機能 性材料」	合同セッションK 「酸化亜鉛系機能 性材料」	合同セッションK 「酸化亜鉛系機能 性材料」	合同セッションK 「酸化亜鉛系機能 性材料」
	ZQ 4F・メモリアルホール	150	13.4 III-V 窒 化物結晶	講演奨励賞贈呈式 特別講演(内閣府) 評議院・研究分野 業績賞授賞式	13.4 III-V 窒 化物結晶	13.6 IV 族系化 合物	5.3 光記録	「研究開発環境の 多様性と評価: 企業における現 状とその課題」	7.1 X線技術	JJAP フレンド シップミーティ ング	合同セッションF 「カーボンナノ チューブの基礎 と応用」	合同セッションF 「カーボンナノ チューブの基礎 と応用」
1号館	ZR 2F-123	155	12.5 半導体光 物性・光デバイ ス	12.5 半導体光 物性・光デバイ ス	12.5 半導体光 物性・光デバイ ス	12.5 半導体光 物性・光デバイ ス	12.5 半導体光 物性・光デバイ ス	12.5 半導体光 物性・光デバイ ス	12.5 半導体光 物性・光デバイ ス	12.5 半導体光 物性・光デバイ ス	12.5 半導体光 物性・光デバイ ス	
体育館	ポスター セッション		6.3 酸化物エ レクトロニクス	[前半] 1.4 プラズマ 応用プロセス 9.2 新材料、新 薄膜、新低温動 作デバイス	15.2 教育 6.3 酸化物エ レクトロニクス	[前半] 7.2 電子顕微鏡、 評価、測定、分 析 10.5 液晶	6.3 酸化物エ レクトロニクス	[前半] 5.3 光記録 10.6 高分子・ソ フトマテリアル	4.6 レーザー分 光応用・計測 8.2 誘電材料・ 誘電体 11.2 半導体表 面		4.6 レーザー分 光応用・計測 8.2 誘電材料・ 誘電体 11.2 半導体表 面	
				[後半] 3.6 視覚・色彩 3.7 生体・医用 光学 10.5 液晶		[後半] 12.4 超高速・機 能デバイス 13.6 IV 族系化 合物		[後半] 12.4 超高速・機 能デバイス 13.6 IV 族系化 合物				